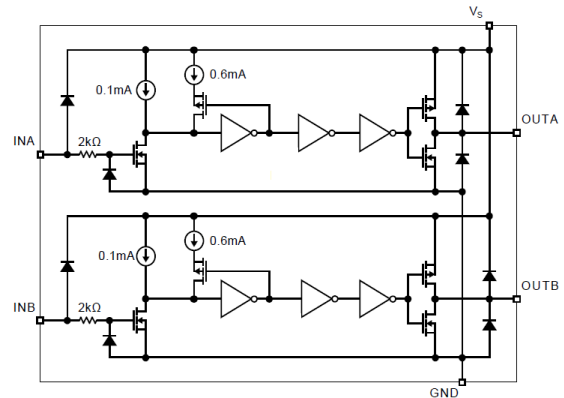




## XA-4426双路MOSFET驱动器规格书

## 主要特点:

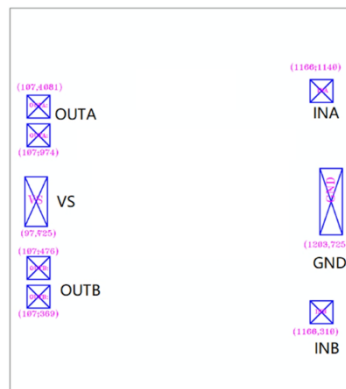
- 高压BICMOS工艺
- 双路1.5A峰值输出电流
- 低静态电流  
4mA, 逻辑高输入  
0.4mA, 逻辑低输入
- 快速开关时间25ns
- 延迟时间40ns
- 7 $\Omega$  输出阻抗
- 高可靠性



## 产品描述:

芯片采用高压、低功耗BICMOS硅工艺制造, 包含两路独立的反相驱动器, 可将TTL/CMOS信号转换为4.5~18V输出。主要用于驱动功率MOSFET, 也可用于驱动电容、电感或电阻等需要低阻抗、大电流、快速开关的应用。可有效替代国外MIC4426/MAX4426等驱动器电路。

## 芯片尺寸:



	X	Y	单位
芯片尺寸	1350	1500	um
焊盘尺寸/栅极	80	80	um

最大额定值: Ta=25℃



参数	符合	额定值	单位
电源电压	VS	22	V
输入电压	VIN	VS+0.3V~GND-5V	V
结温	Tj	175	°C

**主要电特性:**

除另有规定外,  $4.5V \leq VS \leq 18V$ ,  $T_a = 25^\circ C$

参数	符号	条件	Min	Typ	Max	单位
输入特性	逻辑 1 输入电平	$V_{IH}$	—	2.4	1.4	V
	逻辑 0 输入电平	$V_{IL}$	—	1.1	0.8	V
	输入电流	$I_{IN}$	$0V \leq V_{IN} \leq V_S$	-1	1	$\mu A$
输出特性	输出高电平	$V_{OH}$	—	$V_S - 0.025$	—	V
	输出低电平	$V_{OL}$	—	—	0.025	V
	输出电阻	$R_O$	$I_{OUT}=10mA, V_S=18V$	6	10	$\Omega$
开关时间	上升时间	$t_R$	$C_L=1nF$	23	40	ns
	下降时间	$t_F$	$C_L=1nF$	27	40	ns
	延迟时间	$t_{D1}$	$C_L=1nF$	26	40	ns
	延迟时间	$t_{D2}$	$C_L=1nF$	38	60	ns
电源特性	电源电流	$I_S$	$V_{IN}=3V$ (双输入端)	0.6	1.4	8
		$I_S$	$V_{IN}=0V$ (双输入端)	—	0.18	0.6

**包装要求:**

芯片应包装在专用的裸芯片盒里面, 采用防潮、防震和防静电包装。

芯片外包装容器上应注明:

- 芯片型号;
- 检验批识别代码;
- 数量。

**贮存要求:**

裸芯片应贮存在充有氮气的干燥柜里。

**运输要求:**

芯片运输过程中应防雨、雪淋袭和机械撞击。